Oxford 100 Material Etch Rates							
Material:	**SiO2 5% Area**	**SiO2 100% Area**	**SiN 5% Area**	**SiN 100% Area**	**Si**	**S1813 +**	**S1813 +**
Recipe:	**BB CF4/O2 10mT**	**BB CF4/O2 10mT**	**BB CF4/O2 10mT**	**BB CF4/O2 10mT**	**BB CF4/O2 10mT**	**BB CF4/O2 10mT**	**BB O2 10mT**
% Area Etched:	5	100	5	100	5	5	5
Gas 1:	O2	O2	O2	O2	O2	O3	O2
Flow (sccm):	5	5	5	5	5	5	50
Gas 2:	CF4	CF4	CF4	CF4	CF4	CF4	N/A
Flow (sccm):	50	50	50	50	50	50	N/A
Set Pressure (mT):	10	10	10	10	10	10	10
Set Chuck Temperature (°C)	26	28	26	28	26	26	26
Powers:							
ICP Forward (W)	500	500	500	500	500	500	500
RF CCP (W)	100	100	100	100	100	100	100
Average Etch Rate (nm/min):	**113.85**	**94.41**	**163.70**	**161.05**	**164.53**	**251.16**	**705.01**
%Uniformity:	**5.78**	**3.81**	**5.68**	**3.89**	**4.90**	**6.79**	**3.84**
Run to Run %Uniformity	**7.17**	**7.04**	**7.00**	**7.85**	**6.83**	**14.74**	**6.35**
Average Selectivity:							
Material : SiO2 5% Area Etched	1 : 1.00	1 : 1.21	1 : 0.70	1 : 0.71	1 : 0.69	1 : 0.45	N/A
Material: SiO2 100% Area Etched	1 : 0.83	1 : 1.00	1 : 0.58	1 : 0.59	1 : 0.57	1 : 0.38	N/A
Material : SiN 5% Area Etched	1 : 1.44	1 : 1.73	1 : 1.00	1 : 1.02	1 : 0.99	1 : 0.65	N/A
Material : SiN 100% Area Etched	1 : 1.41	1 : 1.71	1 : 0.98	1 : 1.00	1 : 0.98	1 : 0.64	N/A
Material : Si	1 : 1.45	1 : 1.74	1 : 1.00	1 : 1.02	1 : 1.00	1 : 0.66	N/A
Material : S1813 + (BB CF4/O2 10 mT)	1 : 2.21	1 : 2.66	1 : 1.53	1 : 1.56	1 : 1.53	1 : 1.00	N/A
Material : S1813 + (BB O2 10 mT)	1 : 6.19	1 : 7.47	1 : 4.31	1 : 4.38	1 : 4.28	1 : 2.81	N/A